

Электронный модуль коммутатора с гальванической развязкой для коммутации сигналов $\pm 60\text{ В} / \pm 5,0\text{ А}$			2М419А2 АЕЯР.432170.563 ТУ		
Перечень ЭКБ 22-2018 Раздел 1 п. 2 (с. 5)			Патент № 118493 от 20.07.2012		

Особенности:

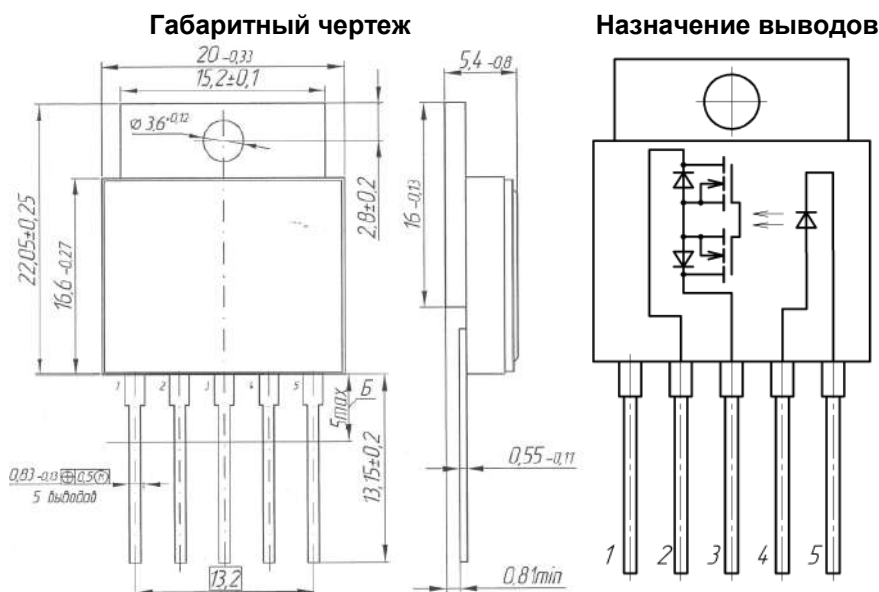
- коммутируемое напряжение $\pm 60\text{ В}$
- коммутируемый ток $\pm 5,0\text{ А}$
- ток управления $5 \dots 25\text{ мА}$
- 1000 В напряжение изоляции;
- 5-выводной металлокерамический корпус КТ-110
- изолированный теплоотвод

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

CPC1708 Clare



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,3	1,6	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}$
Ток утечки на вых. в закр. сост.	$I_{УТ}$	мкА	—	0,1	1,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{ В}, U_{ВЫХ} = 60\text{ В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	—	—	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 10\text{ мкА}; t = 5\text{ с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{ОТК}$	Ом	—	0,07	0,12	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}, I_{ВЫХ} = \pm 5,0\text{ А}, T_{измер.} \leq 30\text{ мс}$
Время включения	$T_{ВКЛ}$	мс	—	5,0	10	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}, U_{КОМ} = 10\text{ В}, R_H = 51\text{ Ом}$
Время выключения	$T_{ВЫКЛ}$	мс	—	0,1	1,0	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}, U_{КОМ} = 10\text{ В}, R_H = 51\text{ Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	- 60	60	- 90	90	
Ток коммутации	А	- 3,0	3,0	- 5	5	При $T \leq 45^\circ\text{C}$
		- 5,0	5,0	- 10	10	С теплоотводом
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	—	50	
Вх. импульсный ток	мА	—	50	—	80	$T_{ИМП} \leq 20\text{ мс}; Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	А	- 12	12	- 20	20	$T_{ИМП} \leq 25\text{ мс}; Q \geq 500$
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	—	40	—	—	Вертикальный монтаж
Тепловое сопротивление кристалл-корпус	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	—	5,5	—	—	
Вх. напряжение в выкл. состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Рабочий диапазон температур	$^\circ\text{C}$	-60	125	—	—	
Температура кристалла транзистора	$^\circ\text{C}$	—	150	—	175	

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			1Ус		0,66 × 2К	0,095 × 2К

Наработка до отказа T_n модулей при температуре окружающей среды не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ должна быть не менее 100 000 ч и не менее 120 000 часов в облегченном режиме: $I_{ВХ} \leq 15\text{ мА}$, $I_{КОМ} \leq 1,5\text{ А}$, $U_{КОМ} \leq 60\text{ В}$, температура от минус 10 до 65°C

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения модулей вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет